# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-058872

(43) Date of publication of application: 06.03.2001

)Int.CI.

CO4B 35/49 H01L 41/187

)Application number: 11-232290

(71)Applicant: TOKIN CORP

!)Date of filing:

19.08.1999

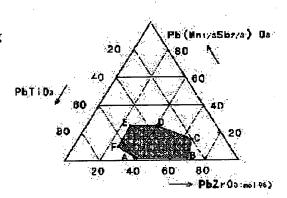
(72)Inventor: SATO KAORU

# I) PIEZOELECTRIC CERAMICS MATERIAL

#### ')Abstract:

OBLEM TO BE SOLVED: To provide a piezoelectric ceramics material pable of being sintered at a low temperature (≤1,000°C) where aporation of PbO can be avoided and capable of being produced at a luced cost.

ILUTION: This piezoelectric ceramics material contains a mixture having composition located inside a region surrounded by a hexagon ABCDEF GHIJKL) in a ternary composition diagram of PbTiO3, PbZrO3, and Pb n1/3 Nb2/3)O3 or Pb(Mn1/3Sb2/3)O3 as principal ingredients and a rtain quantity added of an oxide such as MoO3 or V2O5 as a subsidiary redient.



#### **GAL STATUS**

ate of request for examination]

ate of sending the examiner's decision of rejection]

ind of final disposal of application other than the aminer's decision of rejection or application converted gistration]

ate of final disposal for application]

atent number]

ate of registration]

umber of appeal against examiner's decision of iection]

ate of requesting appeal against examiner's decision of iection]

ate of extinction of right]

# OTICES.\*

an Patent Office is not responsible for any ages caused by the use of this translation.

his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

\*\*\* shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

### **AIMS**

aim(s)] aim 1] It is the oxide piezoelectric-ceramics ingredient which uses PbTiO3, PbZrO3, and Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3 as a scipal component. The presentation on the three-component-system composition diagram of PbTiO3-PbZrO3-Pb 11/3Sb 2/3) O3 A (59-mol% and 40-mol% and one-mol%) and B (29-mol% --) 70-mol% and one-mol%, C (20-l% and 65-mol% and 15-mol%), D (35-mol% and 40-mol% and 25-mol%) and E (50-mol% --) It is within the limits he hexagon ABCDEF surrounded by F (65-mol% and 25-mol% and ten-mol%) (the line top which connects A, B, C, E, and F each point is included) 25-mol% 25-mol%. As an accessory constituent at least one sort among M acid sts (MOx:V 2O5, La2O3, Bi2O3, ZnO, CuO, PbO, WO3), and MoO3 -- containing -- said principal component ght -- receiving -- 10 in all -- less than [ wt% ] (0 is not included) -- the piezoelectric-ceramics ingredient

racterized by containing. aim 2] It is the oxide piezoelectric-ceramics ingredient which uses PbTiO3, PbZrO3, and Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3 as a scipal component. The presentation on the three-component-system composition diagram of PbTiO3-PbZrO3-Pb n1/3Nb 2/3) O3 G (54-mol% and 45-mol% and one-mol%) and H (37-mol% --) 62-mol% and one-mol%, I (20-l% and 50-mol% and 30-mol%), J (25-mol% and 30-mol% and 45-mol%) and K (40-mol% --) It is within the limits he hexagon GHIJKL surrounded by L (55-mol% and 25-mol% and 20-mol%) (the line top which connects G, H, I, J, and L each point is included) 45-mol% 15-mol%. As an accessory constituent at least one sort among M acid ghosts Ox:V 2O5, La2O3, Bi2O3, ZnO, CuO, PbO, WO3), and MoO3 -- containing -- said principal component weight -- eiving -- 10 in all -- less than [ wt% ] (0 is not included) -- the piezoelectric-ceramics ingredient characterized by staining.

anslation done.]

#### **OTICES**\*

an Patent Office is not responsible for any lages caused by the use of this translation.

his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

\*\*\* shows the word which can not be translated.

1 the drawings, any words are not translated.

# TAILED DESCRIPTION

stailed Description of the Invention]

017

eld of the Invention] Especially this invention relates to the piezoelectric-ceramics ingredient used for piezoelectric-amics manufactures, such as various ultrasonic vibrators, a ceramic filter, the piezo-electric sounding body, and an extrostrictive actuator, about a piezoelectric-ceramics ingredient.

021

escription of the Prior Art] In recent years, as a piezoelectric-ceramics ingredient, the electrostrictive ceramics (it reviates to PZT system electrostrictive ceramics hereafter) which contains PbTiO3 and PbZrO3 as a principal nponent is used general-purpose. Generally, the sintering temperature which that manufacture takes at this kind of extrostrictive ceramics is about 1260 degrees C in binary system, and sintering temperature has become low nearly 0 degrees C somewhat in the multicomponent system PZT system electrostrictive ceramics which made compound ovskites dissolve as the third fourth component further for a property improvement.

031

oblem(s) to be Solved by the Invention] By the way, in the sintering course of PZT system electrostrictive ceramics, sknown that evaporation of PbO which is one of the principal components will increase from nearly 1000 degrees C idly, therefore there is a problem that a lot of PbO evaporation takes place, in the above-mentioned temperature field. bO evaporates, when causing a presentation gap of a sintered compact and causing dispersion in a property, and gradation, the lead component which evaporated causes environmental pollution.

[04] Then, on manufacture of PZT system electrostrictive ceramics, it has become very important to control poration of PbO and, for that, it is desirable to make sintering temperature into 1000 degrees C or less. It is expected t palladium will be reduced in the configuration of an internal electrode, and it can increase a silver ratio if sintering perature can be fallen in the case of the laminating mold piezoelectric device really manufactured by baking, and comes advantageous in respect of a manufacturing cost when lowering of sintering temperature is useful also in pect of energy saving. Thus, it is useful to reduce the sintering temperature of a piezoelectric-ceramics ingredient also he point which embodies energy saving, while it is advantageous in respect of a manufacturing cost.

However, in the case of the conventional PZT system electrostrictive ceramics mentioned above, there are the lowing \*\*\*\*. That is, generally, since sintering temperature is usually 1200 degrees C or more, evaporation of PbO is pided or there is a problem from which it becomes difficult to reduce a manufacturing cost.

106] Therefore, it was made that this invention should solve such a trouble, and the technical technical problem is to er the piezoelectric-ceramics ingredient which reduced the manufacturing cost while being able to sinter it at the low aperature (1000 degrees C or less) which can avoid evaporation of PbO.

)Ô71

eans for Solving the Problem] A kind or by making two or more sorts dissolve, by binary system, an improvement of dielectric characteristics which were not obtained and a piezo-electric property is made by PbTi3-PbZrO3, and it is sented with multicomponent PZT system electrostrictive ceramics by practical use in compound perovskites. TiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3 system electrostrictive ceramics and PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3 item electrostrictive ceramics are making Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3 and Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3 dissolve, and thousands of undreds to ] mechanical quality factors and high dielectric characteristics, and a piezo-electric property are acquired. Namely, this invention is an oxide piezoelectric-ceramics ingredient which uses PbTiO3, PbZrO3, and Pb n1/3Sb 2/3) O3 as a principal component. The presentation on the three-component-system composition diagram of TiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3 A (59-mol% and 40-mol% and one-mol%) and B (29-mol% --) 70-mol% and e-mol%, C (20-mol% and 65-mol% and 15-mol%), D (35-mol% and 40-mol% and 25-mol%) and E (50-mol% --) It

vithin the limits of the hexagon ABCDEF surrounded by F (65-mol% and 25-mol% and ten-mol%) (the line top ich connects A, B, C, D, E, and F each point is included) 25-mol% 25-mol%. As an accessory constituent at least one t among M acid ghosts (MOx:V 2O5, La2O3, Bi2O3, ZnO, CuO, PbO, WO3), and MoO3 -- containing -- said acipal component weight -- receiving -- 10 in all -- less than [ wt% ] (0 is not included) -- it is the contained zoelectric-ceramics ingredient.

09] Moreover, this invention is an oxide piezoelectric-ceramics ingredient which uses PbTiO3, PbZrO3, and Pb n1/3Nb 2/3) O3 as a principal component. The presentation on the three-component-system composition diagram of FiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3 G (54-mol% and 45-mol% and one-mol%) and H (37-mol% --) 62-mol% and >-mol%, I (20-mol% and 50-mol% and 30-mol%), J (25-mol% and 30-mol% and 45-mol%) and K (40-mol% --) It is hin the limits of the hexagon GHIJKL surrounded by L (55-mol% and 25-mol% and 20-mol%) (the line top which meets G, H, I, J, K, and L each point is included) 45-mol% 15-mol%. As an accessory constituent at least one sort ong M acid ghosts (MOx:V 2O5, La2O3, Bi2O3, ZnO, CuO, PbO, WO3), and MoO3 -- containing -- said principal nponent weight -- receiving -- 10 in all -- less than [ wt% ] (0 is not included) -- it is the contained piezoelectric-amics ingredient.

10] In this invention, in PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3 system or PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3 tem, as an accessory constituent Sintering temperature can be fallen to 1000 degrees C or less by adding a kind and

O3 [one in all quantum] at least among V2O5, La2O3, Bi2O3, and ZnO, CuO, PbO and WO3.

nbodiment of the Invention] Below, the gestalt of implementation of invention of this invention is explained, erring to a drawing.

12] Drawing 1 is drawing showing the presentation range by the gestalt of operation of the 1st of this invention.

- 13] The presentation range of a principal component is expressed on the three-component-system composition gram of PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3. A (59-mol% and 40-mol% and one-mol%) and B (29-mol% --) 70-1% and one-mol%, C (20-mol% and 65-mol% and 15-mol%), It is within the limits of the hexagon ABCDEF rounded by D (35-mol% and 40-mol% and 25-mol%), E (50-mol% and 25-mol% and 25-mol%), and F (65-mol% 125-mol% and ten-mol%) (the line top which connects A, B, C, D, E, and F each point is included).
- 114] The following explains the piezoelectric-ceramics ingredient of this invention based on a concrete example (the imple of a comparison is included) including the manufacture process.
- As a raw material of a principal component and an accessory constituent, PbO, TiO2, ZrO2, MnCO3, Sb2O3, O3, V2O5, La2O3, Bi2O3, and ZnO, CuO and WO3 were prepared so that it might become a predetermined sentation, respectively, and with the zirconia ball, such raw material powder was put in into the acrylic pot, and ried out wet blending to the beginning for 20 hours.
- Next, after performing \*\*\*\* for such mixed powder in alumina \*\*\*\*\* after dehydration desiccation, wet nding of each \*\*\*\*\* was carried out with the zirconia ball in an acrylic pot for 15 hours.
- 117] Then, the binder was mixed to the \*\*\*\* pulverized powder obtained by carrying out dehydration desiccation, it s pressurized, and it fabricated in the diameter of 15mm, and thickness of 3mm. After calcinating this Plastic solid at ) degrees C 1050 degrees C for 2 hours and processing each sintered compact into the thickness of 1mm, the silver ste was applied to both sides and it considered as the sample by being burned at 450 degrees C and forming an etrode
- 118] Thus, polarization processing was carried out for each obtained sample in 100 degrees C, 4kV/, and 15 minutes n, and specific-inductive-capacity epsilonr, the electromechanical coupling coefficient Kp, and the mechanical quality tor Qm were measured. A measurement result is shown in a table 1 with the presentation of each sample. In addition, a table 1, T.S. is sintering temperature and showed the temperature which is the need and which can most be sintered ow temperature to that the sintered compact consistency rho becomes three or more 7.5 g/cm.

table 1]

)191

٦	. 組 成 <sup>2</sup>	特性"				焼結体外観 <sup>6</sup>
j	a b c d	T.S.	ΕĪ	Кр	Qm	
	64 35 1 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>2</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>2</sub> )	910℃		15%		
	59 40 1 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	900℃	430	25%	510	<u> </u>
٦	44 55 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	900℃	1080	49%	500	
-	29 70 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	. 890 °C	400	26%	520	
*	27; 72; 1; 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	890 ℃	300			
*	70: 20: 10: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	380 ℃	580		2210	
_	65 25 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	880 ℃	620	·	2470	
_	45 45 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	870 ℃		51%	1100	
_	30 60 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	870 ℃	410	26%	3500	
*	20 70 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	870 ℃	330		4750	
*	60 25 15 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	860℃	700		1060	
_	55 30 15 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	850℃	750		1110	
_	35 50 15 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	840 °C	1150	47%	1950	
_	20; 65; 15; 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )			26%		
*	17: 68: 15: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )			25%		
*	53: 22: 25: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>5</sub> )	810 ℃				
	50 25 25 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	810℃	·		510	
-	35 40 25 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>5</sub> )	810 ℃		27%		<del></del>
*	32 43 25 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800℃	1		1070	
	51 45 4 0	1180℃	<u>.                                      </u>			
_	51 45 4 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>5</sub> )	880 ℃			1400	
_	51 45 4 2 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	℃ 038	<del> </del>		<del></del>	
_	51 45 4 5 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	850 ℃			1140	+
	51 45 4 8 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃			990	<del></del>
*	51 45 4 10 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 40M <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	820 ℃			800	
	51 45 4 1 (40V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -60MoO <sub>3</sub> )	870 ℃			1270	
	51 45 4 1 (10La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -90MoO <sub>3</sub> )		1270		1120	
_	51 45 4 1 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	860℃	1300		1060	<del></del>
_	50 40 10 1 (20ZnO-80MoOs)	870 ℃			1860	
_	50 40 10 2 (30CuO-70MoO <sub>3</sub> )	860 °C	950		1690	<del></del>
_	50 40 10 2 (42PbO-8WO-50MoO <sub>3</sub> )	850 ℃	910		1740	
_	50: 40: 10: 2(35PbO-5La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -60MoO <sub>3</sub> )		940		1630	
_	50: 40: 10: 5 (28PbO-7CuO-65MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	990		1550	
	50 40 10 5 (25Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -75MoO <sub>3</sub> )	840 ℃	1000		1410	
*	50 40 10 10 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	800 ℃	910	31%	940	組織不均一

\*のついたものは、本発明の請求範囲外。

a、b、cの単位は mol%、dの単位は wt% である。

また、dの()内は、副成分の組成をmol比で示している。

T.S.は焼結体密度が7.5g/cm<sup>1</sup>以上となるのに必要な最低の焼結温度。

空欄は、組織が均一で外観上良好なもの。

)20] About a piezoelectric-ceramics ingredient, as a reason which limits the presentation range, epsilonr<400 of each nple, and Kp<25%, a property deteriorates, and in this invention, since it is lacking in practicability, the thing of n<500 is excepted from this invention. Moreover, when the addition of an accessory constituent exceeds the generic im of this invention, it becomes uneven, and since it is not desirable, an organization is excluded.

)21] The presentation range can be determined by eliminating the sample applicable to such an unsuitable matter, and

sample in which the property deteriorated.

)22] An example is shown in drawing 3 about the relation between the sintering temperature of a typical sample, and intered compact consistency. At least 1000 degrees C or less of sufficient sintered compact consistencies were tained.

Praying 2 is drawing showing the presentation range by the gestalt of operation of the 2nd of this invention. The presentation range of a principal component is expressed on the three-component-system composition gram of PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3. G (54-mol% and 45-mol% and one-mol%) and H (37-mol% --) 62-% and one-mol%, I (20-mol% and 50-mol% and 30-mol%), It is within the limits of the hexagon GHIJKL ounded by J (25-mol% and 30-mol% and 45-mol%), K (40-mol% and 15-mol% and 45-mol%), and L (55-mol% 25-mol% and 20-mol%) (the line top which connects G, H, I, J, K, and L each point is included).

25] Like the gestalt of operation of the 1st of this invention, as a raw material of a principal component and an essory constituent, PbO, TiO2, ZrO2, MnCO3, Nb2O3, MoO3, V2O5, La2O3, Bi2O3, and ZnO, CuO and WO3 e prepared so that it might become the presentation of each sample shown in a table 2, respectively. After that, it utfactured by the same approach as the gestalt of operation of the 1st of this invention, and many properties were stured. The result at that time is shown in a table 2.

26]

able 2]

٦	組成立	特性"				焼結体外観り
	e if ig ih	T.S.	£ f	Кр	Qm	
7	59: 40: 1: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	900℃	370			
7	54 45 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	900℃	420	26%	600	
٦	44: 55: 1: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	890 ℃	980	50%	550	
-	37 62 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	890 °C	550	27%	750	
	34 65 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	880 ℃	400	18%	890	
	60: 20: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	420	16%	1630	
_	55: 25: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	830 ℃	530	25%	2100	
	40: 40: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	1020	55%	1570	
_	25: 55: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	820 ℃	470	28%	3200	
•	20: 60: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃	380	25%	4100	
•	55 15 30 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃	560	24%	1200	
_	45 25 30 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>2</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	820 ℃	710	29%	1150	
_	30 40 30 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃	1160	44%	1780	
-	20: 50: 30: 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	810 ℃	520	28%	2430	
•	15 55 30 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	810 ℃	430	24%	2610	
•	45: 10: 45: 1 (60V <sub>1</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800 ℃	860	13%	320	
_	40: 15: 45: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	2008	880	25%	500	
_	25 30 45 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800 ℃	700	26%	760	
•	15 40 45 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )		640	15%	950	
*	47 48 5 0	1170℃	1110	62%	1660	
_	47: 48: 5: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	860 ℃	1200	60%	1300	
_	47 48 5 2(60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	840 ℃	1220	60%	1250	
_	47 48 5 5 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	1230	59%	1230	
_	47: 48: 5: 8(60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800°C	1210	55%	1100	
*	47: 48: 5:10(60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	790℃	1190	47%	970	組織不均一
_	47 48 5 1 (40V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -60MoO <sub>5</sub> )	850℃	1210	59%	1270	
	47 48 5 1 (10La <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -90MoO <sub>2</sub> )	870 ℃				
_	47 48 5 1 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	840 ℃			1090	
	45 40 15 1 (20ZnO-80MoO <sub>3</sub> )	850°C	1080	54%	1450	)
_	45 40 15 2(30CuO-70MoO <sub>3</sub> )	840 ℃	1130	52%	1340	
_	45; 40; 15; 2(42PbO-8WO)-50MoO <sub>3</sub> )	820 ℃			1210	
_	45: 40: 15: 2(35PbO-5La <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -60MoO <sub>2</sub> )	830 ℃			1260	
_	45: 40: 15: 5(28PbO-7CuO-65MoO <sub>2</sub> )	810 ℃				
_	45: 40: 15: 5(25Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -75MoO <sub>3</sub> )	830 ℃				
*	45 40 15 10 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	780 ℃	1210	40%	950	組織不均一

\*のついたものは、本発明の請求範囲外。 e、f、gの単位は mol%、hの単位は wt%である。 また、hの()内は、副成分の組成を示している。 「.S.は焼結体密度が 7.5g/cm'以上となるのに必要な最低の焼結温度。 空欄は、組織が均一で外観上良好なもの。

About a piezoelectric-ceramics ingredient, like the gestalt of operation of the 1st of this invention as a reason ich limits the presentation range, epsilonr<400 of each sample, and Kp<25%, a property deteriorates, and in this ention, since it is lacking in practicability, the thing of Qm<500 is excepted from this invention. Moreover, when the lition of an accessory constituent exceeds the generic claim of this invention, it becomes uneven, and since it is not sirable, an organization is excluded. Therefore, the piezoelectric-ceramics ingredient which can be calcinated at low aperature 1000 degrees C or less with a high property is obtained by considering as this presentation range.

128] The presentation range can be determined by eliminating the sample applicable to such an unsuitable matter, and sample in which the property deteriorated.

fect of the Invention] According to [ as stated above ] this invention, it is PbTiO3 and PbZrO3 as a principal aponent and an accessory constituent, Pb(Mn1/3Sb 2/3) O3, Pb(Mn1/3Nb 2/3) O3, and Mox and MoO3 (however, x). It can sinter at the low temperature 1000 degrees C or less which can avoid evaporation of PbO by using in the imum dose range. V2 -- a kind is included at least among O5, La 2O3, Bi2O3, and ZnO, CuO, PbO and WO3 -- rying out -- And specific-inductive-capacity epsilonr becomes possible [ offering the piezo electric crystal ingredient h which 400 or more and an electromechanical coupling coefficient Kp have 25% or more, and a mechanical quality tor Qm has 500 or more outstanding properties by energy saving and low cost ]. Therefore, this invention is ustrially useful.

anslation done.]

# **OTICES** \*

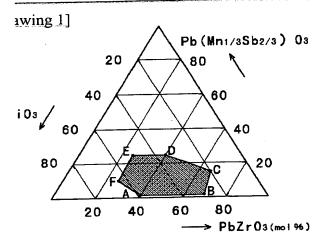
an Patent Office is not responsible for any ages caused by the use of this translation.

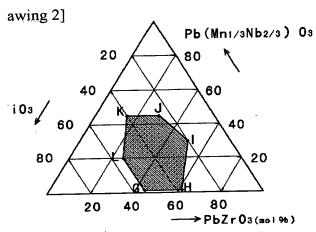
nis document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

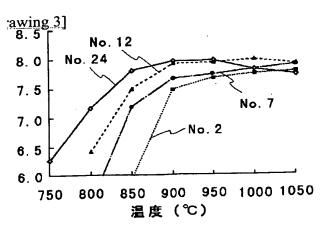
\*\*\* shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

# **AWINGS**







inslation done.]



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-58872

(P2001-58872A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(51) Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

C 0 4 B 35/49

H01L 41/187

C 0 4 B 35/49

K 4G031

H01L 41/18

101F

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号

特願平11-232290

(71)出顧人 000134257

株式会社トーキン

(22)出願日

平成11年8月19日(1999.8.19)

宫城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

(72)発明者 佐藤 薫

宫城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

株式会社トーキン内

Fターム(参考) 40031 AA09 AA11 AA12 AA13 AA18

AA19 AA25 AA26 AA32 AA34

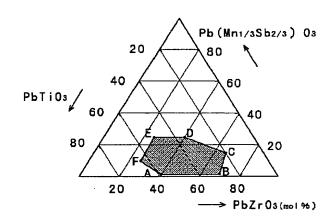
AA35 BA10

#### (54) 【発明の名称】 圧電磁器材料

#### (57)【要約】

【課題】 PbOの蒸発を回避できる低温(1000℃ 以下)で焼結可能であるとともに、製造コストを低減し た圧電磁器材料を提供すること。

【解決手段】 PbTiO3、PbZrO3、Pb(M 1/3 Sb2/3 ) О3 を主成分とする三元組成図上 で、六角形ABCDEF(あるいは、GHIJKL)で 囲まれた範囲内と、副成分として、MoO3とV2O5 等の酸化物を一定量添加した圧電磁器材料。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 PbTiO3、PbZrO3、Pb(M n1/3 Sb2/3 ) O3 を主成分とする酸化物圧電磁 器材料であって、その組成が、PbTiO3-PbZr O3-Pb (Mn1/3 Sb2/3 ) O3 の三成分系組 成図上で、A (59mol%、40mol%、1mol %) \ B (29mo1%, 70mo1%, 1mo1 %) 、C (20mo1%、65mo1%、15mo1 %) 、D (35mol%、40mol%、25mol %) \ E (50mo1%, 25mo1%, 25mo1 %) F (65mol%, 25mol%, 10mol %) で囲まれる六角形ABCDEFの範囲内(A, B, C. D. E. F各点を結ぶ線上を含む)にあり、かつ、 副成分として、M酸化物(MOx: V2O5, La2O 3, Bi2O3, ZnO, CuO, PbO, WO3) O うち、少なくとも1種とMoO3とを含み、前記主成分 重量に対して、合わせて10wt%未満(0を含まず) 含有していることを特徴とする圧電磁器材料。

【請求項2】 PbTiO3、PbZrO3、Pb(M n1/3 Nb2/3 ) O3 を主成分とする酸化物圧電磁 器材料であって、その組成が、PbTiO3-PbZr O3-Pb (Mn1/3 Nb2/3 ) O3の三成分系組 成図上で、G (54mol%、45mol%、1mol %) \ H (37mo1%, 62mo1%, 1mo1 %), I (20mol%, 50mol%, 30mol %) \ J (25mo1%\ 30mo1%\ 45mo1 %) 、K (40mol%、15mol%、45mol %) L (55mo1%, 25mo1%, 20mo1 %) で囲まれる六角形 GHIJK Lの範囲内(G, H, I, J, K, L各点を結ぶ線上を含む)にあり、かつ、 副成分として、M酸化物(MOx: V2O5, La2O 3, Bi2O3, ZnO, CuO, PbO, WO3) Ø うち、少なくとも1種とMoO3とを含み、前記主成分 重量に対して、合わせて10wt%未満(0を含まず) 含有していることを特徴とする圧電磁器材料。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電磁器材料に関し、特に、各種超音波振動子、セラミックフィルタ、圧電発音体、圧電アクチュエータ等の圧電磁器製造物に利用される圧電磁器材料に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、圧電磁器材料としては、PbTiO3やPbZrO3を主成分として含む圧電セラミックス(以下、PZT系圧電セラミックスと略す)が汎用的に用いられている。一般に、この種の圧電セラミックスでは、その製造に要する焼結温度が二成分系では約1260℃であり、さらに特性改善のために複合ペロブスカイト類を第三、第四成分として固溶させた多成分系PZT系圧電セラミックスでは、焼結温度が多少低い120

0℃近辺となっている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、PZT系圧電セラミックスの焼結課程において、主成分の一つであるPbOの蒸発が1000℃近辺から急激に増加することが知られている、従って、上記の温度領域では、多電のPbO蒸発が起こるという問題がある。PbOが蒸発すると、焼結体の組成ずれを引き起こし、特性のばらつきや劣化を招く上、蒸発した鉛成分は環境汚染の原因ともなる。

【0004】そこで、PbOの蒸発を制御することは、PZT系圧電セラミックスの製造上、非常に重要となっており、このためには、焼結温度を1000℃以下にすることが望ましい。焼結温度の低下は、省エネルギーの点でも有益である上に、例えば、一体焼成で製造される積層型圧電素子の場合、焼結温度が低下できれば、内部電極の構成においてパラジウムを減らし、銀の比率を増大させることが可能であり、製造コスト面で有利となると期待される。このように、圧電磁器材料の焼結温度を低下させることは、製造コスト面で有利であるとともに、省エネルギーを具現化する点でも有益である。

【0005】しかし、上述した従来のPZT系圧電セラミックスの場合には、次のような決点がある。即ち、一般に、焼結温度が通常1200℃以上であるため、PbOの蒸発を回避したり、あるいは製造コストを低減させることが困難となる問題がある。

【0006】従って、本発明は、このような問題点を解決すべくなされたもので、その技術的課題は、PbOの蒸発を回避できる低温(1000℃以下)で焼結可能であるとともに、製造コストを低減した圧電磁器材料を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】多成分のPZT系圧電セラミックスは、PbTi3-PbZrO3に複合ペロブスカイト類を一種もしくは複数種固溶させることにより、二成分系では得られなかった誘電特性、圧電特性の改善がなされて、実用に供されている。PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3 Sb2/3 )O3系圧電セラミックスおよびPbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3 Nb2/3 )O3系圧電セラミックスは、Pb(Mn1/3 Sb2/3 )O3条圧電セラミックスは、Pb(Mn1/3 Sb2/3 )O3条Pb(Mn1/3 Nb2/3 )O3を固溶させることで、数百から数千の機械的品質係数および高い誘電特性、圧電特性が得られている。

【0008】即ち、本発明は、PbTiO3、PbZrO3、Pb(Mn1/3 Sb2/3 )O3を主成分とする酸化物圧電磁器材料であって、その組成が、PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3 Sb2/3 )O3の三成分系組成図上で、A(59mol%、40mol%、1mol%)、B(29mol%、70mol

2

3

%、1 mo 1%)、C(20 mo 1%、65 mo 1%、15 mo 1%)、D(35 mo 1%、40 mo 1%、25 mo 1%)、E(50 mo 1%、25 mo 1%、25 mo 1%)、F(65 mo 1%、25 mo 1%、10 mo 1%)で囲まれる六角形ABCDEFの範囲内(A,B,C,D,E,F各点を結ぶ線上を含む)にあり、かつ、副成分として、M酸化物(MOx:V2O5,La2O3,Bi2O3,ZnO,CuO,PbO,WO3)のうち、少なくとも1種とMoO3とを含み、前記主成分重量に対して、合わせて10 wt%未満(0を含まず)含有している圧電磁器材料である。

【0009】また、本発明は、PbTiO3、PbZr O3、Pb (Mn1/3 Nb2/3 ) O3を主成分とす る酸化物圧電磁器材料であって、その組成が、PbTi  $O_3 - PbZrO_3 - Pb (Mn_{1/3} Nb_{2/3}) O$ 3 の三成分系組成図上で、G (5 4 m o 1 %、 4 5 m o 1%, 1mol%), H (37mol%, 62mol %、1mo1%)、I(20mo1%、50mo1%、 30mol%), J (25mol%, 30mol%, 4 5mol%) 、K (40mol%、15mol%、45 mo1%), L (55mo1%, 25mo1%, 20m ol%) で囲まれる六角形 GHIJK Lの範囲内 (G, H, I, J, K, L各点を結ぶ線上を含む) にあり、か つ、副成分として、M酸化物(MOx: V2O5, La 2 O 3, B i 2 O 3, Z n O, C u O, P b O, W 〇3) のうち、少なくとも1種とMoO3とを含み、前 記主成分重量に対して、合わせて10wt%未満(0を 含まず) 含有している圧電磁器材料である。

【0010】本発明では、PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mni/3 Sb2/3 )O3系あるいはPbTiO3-PbZrO3-Pb(Mni/3 Nb2/3 )O3系に、副成分として、V2O5、La2O3、Bi2O3、ZnO、CuO、PbO、WO3のうち少なくとも一種とMoO3とを合わせて一定量添加することで、焼結温度を1000℃以下に低下することができる。

## [0011]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0012】図1は、本発明の第1の実施の形態による 組成範囲を示す図である。

【0013】主成分の組成範囲は、PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mn1/3 Sb2/3)O3の三成分系組成図上で表され、A(59mol%、40mol%、1mol%)、B(29mol%、70mol%、1mol%)、C(20mol%、65mol%、15mol%)、D(35mol%、40mol%、25mol%)、E(50mol%、25mol%、25mol%、25mol%、25mol%、10mol%)で囲まれる六角形ABCDEFの範囲内(A, B, C, D, E, F各点を結ぶ線上を含む)にある。

【0014】以下は、本発明の圧電磁器材料を、その製造過程を含めて具体的な例(比較例を含む)に基づいて説明する。

【0015】最初に、主成分および副成分の原料として、PbO、TiO2、ZrO2、MnCO3、Sb2O3、MoO3、V2O5、La2O3、Bi2O3、ZnO、CuO、WO3を、それぞれ所定の組成となるように調製し、これらの原料粉をジルコニアボールとともにアクリルポット中に入れ、20時間湿式混合した。【0016】次に、これらの混合粉を脱水乾燥後、アルミナこう鉢中で予焼を行ってから、各予焼粉をアクリルポット中ジルコニアボールにて15時間湿式粉砕した。【0017】引き続き、脱水乾燥して得られた予焼粉砕粉にバインダを混合して加圧し、直径15mm、厚み3mmに成形した。この成形体を750 $^{\circ}$ ~1050 $^{\circ}$ で2時間焼成し、各焼結体を1mmの厚さに加工した後、両面に銀ペーストを塗布して、450 $^{\circ}$ で焼き付けて電極を形成することにより試料とした。

[0019]

【表1】

40

No. <sup>n</sup>	組成り	特性"	焼結体外観 <sup>0</sup>
	a b c d	T.S. Er Kp Qm	
1 *	64: 35: 1: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	910 ℃ 350 15% 450	<del></del>
2	59 40 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	900 ℃ 430 25% 510	
3	44 55 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	900 ℃ 1080 49% 500	
4	29: 70; 1: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	890 °C : 400 : 26% : 520	
5 *	27: 72: 1: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	890 °C   300   19%   510	
6*	70: 20: 10: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>5</sub> )	880 °C : 580: 18% :2210	
7	65 25 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	880 °C : 620 : 27% :2470	
8	45 45 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	870 °C 1110 51% 1100	
9	30 60 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>5</sub> )	870 °C 410 26% 3500	
10 *	20 70 10 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	870 ℃ 330 16% 4750	
11 *	60 25 15 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	860 °C 700 24% 1060	
12	55 30 15 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	850 °C : 750: 28% :1110	
13	35 50 15 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	840 ℃ 1150: 47% 1950	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14	20: 65: 15: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	840 ℃ : 410: 26% :3920	
15 *	17: 68: 15: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	840 °C   390   25%   4140	
16 *	53: 22: 25: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	810℃ : 980 : 21% : 360	
17	50; 25; 25; 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	810 ℃ 1090 28% 510	
18	35 40 25 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	810°C   870   27%   630	
19 *	32 43 25 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800 ℃ 750 24% 1070	
20 *	51 45 4 0	1180 ℃ 1220 59% 1750	
21	51 45 4 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	880 °C 1250 58% 1400	
22	51 45 4 2 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	860 °C 1290 57% 1260	
23	51 45 4 5 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	850 ℃ 1330: 57% 1140	
24	51: 45: 4: 8(60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃ 1180 55% 990	
25 *	51: 45: 4:10(60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃ 1020 : 49% : 800	組織不均一
26	51 45 4 1 (40V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -60MoO <sub>3</sub> )	870 ℃ 1310: 57% 1270	
27	51 45 4 1 (10La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -90MoO <sub>3</sub> )	890 ℃ 1270 58% 1120	
28	51 45 4 1 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	860 °C   1300   55%   1060	
29	50 40 10 1 (20ZnO-80MoO <sub>3</sub> )	870 ℃   940   41%   1860	
30	50 40 10 2 (30CuO-70MoO <sub>3</sub> )	860 °C   950   40%   1690	
31	50 40 10 2(42PbO-8WO <sub>3</sub> -50MoO <sub>3</sub> )	850 °C 910 43% 1740	
32	50 40 10 2(35PbO-5La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -60MoO <sub>3</sub> )	840°C : 940 : 42% :1630	
33	50: 40: 10: 5 (28PbO-7CuO-65MoO <sub>3</sub> )	830 ℃: 990: 40%:1550	
34	50 40 10 5 (25Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -75MoO <sub>3</sub> )	840 ℃ 1000 39% 1410	
35 *	50 40 10 10 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	800 ℃   910   31%   940	組織不均一

- 1)\*のついたものは、本発明の請求範囲外。
- a、b、cの単位は mol%、dの単位は wt%である。
   また、dの()内は、副成分の組成を mol 比で示している。
- 3)T.S.は焼結体密度が 7.5g/cm<sup>2</sup>以上となるのに必要な最低の焼結温度。
- 4)空欄は、組織が均一で外観上良好なもの。

【0020】本発明において、圧電磁器材料に関して、その組成範囲を限定する理由として、各試料のうちの  $\varepsilon$  r < 400、K p < 25%、Qm < 500のものは、特性が劣化して実用性に乏しいため、本発明からは除外される。また、副成分の添加量が本発明の請求範囲を超えた場合、組織が不均一となり、好ましくないため除外される。

【0021】このような不適事項に該当する試料と特性が劣化した試料とを排除することにより、組成範囲を決定することができる。

【0022】図3に、代表的な試料の焼結温度と焼結体密度の関係について例を示す。1000℃以下でも十分な焼結体密度が得られた。

【0023】図2は、本発明の第2の実施の形態による 組成範囲を示す図である。

【0024】主成分の組成範囲は、PbTiO3-PbZrO3-Pb(Mni/3 Nb2/3)O3の三成分系組成図上で表され、G(54mol%、45mol%、1mol%)、H(37mol%、62mol%、1mol%)、I(20mol%、50mol%、30

mo1%)、J(25mo1%、30mo1%、45mo1%)、K(40mo1%、15mo1%、45mo1%)、L(55mo1%、25mo1%、20mo1%)で囲まれる六角形GHIJKLの範囲内(G, H, I, J, K, L各点を結ぶ線上を含む)にある。

【0025】本発明の第1の実施の形態と同様に、主成 分および副成分の原料として、PbO、TiO2、Zr O2、MnCO3、Nb2O3、MoO3、V2O5、 La2O3、Bi2O3、ZnO、CuO、WO3を、それぞれ表2に示す各試料の組成となるように調製した。その後は、本発明の第1の実施の形態と同様な方法で製造し、諸特性を測定した。その時の結果を表2に示す。

【0026】 【表2】

No."	組 成 "	特性*				焼結体外観り
	e f g h	Z.T	Εſ	Кр	Qm	
36 *	59 40 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>5</sub> )	900 ℃	370	14%	980	
37	54 45 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	900 ℃	420	26%	600	
38	44 55 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40M <sub>0</sub> O <sub>3</sub> )	890 ℃	980	50%	550	
39	37 62 1 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>1</sub> -40MoO <sub>1</sub> )	890 ℃	550	27%	750	
40 *	34; 65; 1; 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	\$80 ℃	400	18%	890	
41 *	60: 20: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	420	16%	1630	
42	55: 25: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	530	25%	2100	
43	40: 40: 20: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>5</sub> )	830 ℃				
44	25 55 20 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>5</sub> )	820 ℃	470	28%	3200	
45 *	20 60 20 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃		25%		
46 *	55 15 30 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃	560	24%	1200	
47	45 25 30 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃				
48	30 40 30 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	820 ℃	1160	44%	1780	
49	20: 50: 30: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	810℃	520	28%	2430	
50 +	15 55 30 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	810℃	430	24%	2610	
51 *	45 10 45 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800 ℃	860	13%	320	
52	40: 15: 45: 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800℃	880	25%	500	
53	25 30 45 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800℃	700	26%	760	
54 *	15 40 45 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	790℃	640	15%	950	
55 *	47: 48: 5: 0	1170℃	1110	62%	1660	
56	47 48 5 1 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	860℃	1200	60%	1300	
57	47 48 5 2 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	840 ℃	1220	60%	1250	
58	47: 48: 5: 5 (60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	830 ℃	1230	59%	1230	
59	47: 48: 5: 8(60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	800 ℃	1210	55%	1100	
60 *	47 48 5:10(60V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -40MoO <sub>3</sub> )	790℃	1190	47%	970	組織不均一
61	47 48 5 1 (40V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -60MoO <sub>3</sub> )	850 ℃	1210	59%	1270	······································
62	47 48 5 1 (10La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -90MoO <sub>3</sub> )	870 ℃			_	
63	47 48 5 1 (20Bi <sub>2</sub> O <sub>1</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	840 ℃	1250	50%	1090	
64	45 40 15 1 (20ZnO-80MoO <sub>3</sub> )	850℃				
65	45 40 15 2(30CuO-70MoO <sub>3</sub> )	840 ℃				
66	45: 40: 15: 2(42PbO-8WO <sub>3</sub> -50MoO <sub>3</sub> )	820℃				* *
67	45: 40: 15: 2(35PbO-5La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -60MoO <sub>3</sub> )	830 ℃				
68	45; 40; 15; 5(28PbO-7CuO-65MoO <sub>1</sub> )	810 °C ∶				
69	45 40: 15 5 (25Bi <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -75MoO <sub>3</sub> )	830℃				
70 *	45; 40; 15;10(20Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -80MoO <sub>3</sub> )	780℃				組織不均一

- 1)\*のついたものは、本発明の請求範囲外。
- e、f、gの単位は moi%、hの単位は wt%である。
   また、hの()内は、副成分の組成を示している。
- 3)T.S.は焼結体密度が7.5g/cm'以上となるのに必要な最低の焼結温度。
- 4)空欄は、組織が均一で外観上良好なもの。

【0027】本発明において、圧電磁器材料に関して、 施の形態と同様に、各試料のうちの $\varepsilon$ r< 400、Kp その組成範囲を限定する理由として、本発明の第1の実 50 < 25%、Qm< 500のものは、特性が劣化して実用

10

性に乏しいため、本発明からは除外される。また、副成分の添加量が本発明の請求範囲を超えた場合、組織が不均一となり、好ましくないため除外される。よって、この組成範囲とすることで、高特性で、1000℃以下の低温で焼成可能な圧電磁器材料が得られる。

【0028】このような不適事項に該当する試料と特性が劣化した試料とを排除することにより、組成範囲を決定することができる。

#### [0029]

【発明の効果】以上に述べたとおり、本発明によれば、 主成分および副成分としてのPbTiO3、Pb.ZrO3、Pb (Mn1/3 Sb2/3 )O3、Pb (Mn1/3 Nb2/3 )O3、Mox, MoO3 (ただしMoxは、V2O5、La2O3、Bi2O3、ZnO、CuO、PbO、WO3のうち少なくとも一種を含むこととする)を適量範囲で用いることにより、PbOの蒸 発を回避できる1000 ℃以下の低温で焼結可能で、しかも比誘電率 $\epsilon$  r が400以上、電気機械結合係数K p が25%以上、機械的品質係数Qmが500以上の優れた特性を有する圧電体材料を省エネルギー、低コストで提供することが可能となる。従って、本発明は、工業的に有益である。

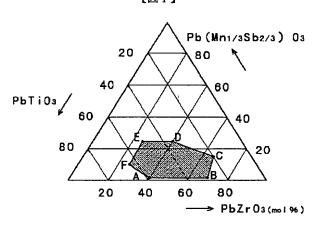
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態によるPbTi O3、PbZrO3、Pb(Mni/3 Sb2/3 ) O 3の三元組成図。

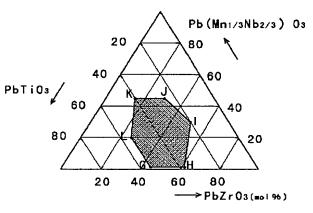
【図2】本発明の第2の実施の形態によるPbTi O3、PbZrO3、Pb(Mn1/3 Nb2/3 ) O 3の三元組成図。

【図3】本発明の第1の実施の形態による各試料のうちの代表的なものに関する焼結温度に対する焼結体密度の関係を示す図。

【図1】



【図2】



【図3】

